

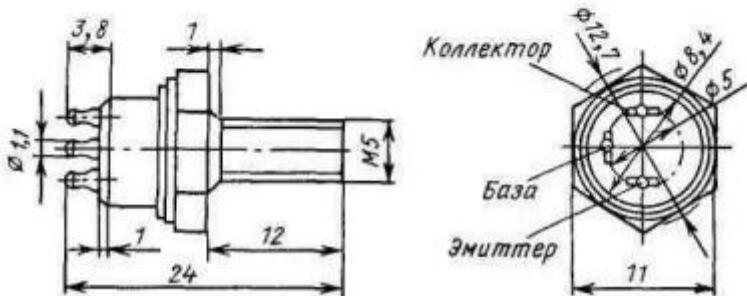
2T606A, KT606A, KT606B

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные *n-p-n* генераторные сверхвысокочастотные

Предназначены для применения в схемах усилителей мощности, в том числе при амплитудной модуляции в умножителях частоты и автогенераторах на частотах выше 100 МГц при напряжении питания 28 В

Выпускаются в металлокерамическом корпусе с изолированными от корпуса жесткими выводами с монтажным винтом. Обозначение типа приводится на корпусе.

Масса транзистора не более 6 г.



Электрические параметры

Выходная мощность при $U_{K\bar{E}} = 28$ В, $f = 400$ МГц, не менее		
2T606A, KT606A	0,8 Вт	
KT606B	0,6 Вт	
Коэффициент усиления по мощности не менее	2,5	
типовое значение	3*	
Коэффициент полезного действия коллектора не ме- нее	35%	
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер* при $I_K =$ $= 200$ мА, $I_B = 40$ мА не более	1,0 В	
Модуль коэффициента передачи тока при $f = 100$ МГц, $U_{K\bar{E}} = 10$ В, $I_K = 100$ мА не менее:		
2T606A, KT606A	3,5	
KT606B	3	
Критический ток коллектора при $U_{K\bar{E}} = 10$ В, $f = 100$ МГц не менее	100 мА	
Постоянная времени цепи обратной связи при $U_{K\bar{B}} =$ $= 10$ В, $f = 5$ МГц, $I_E = 30$ мА не более:		
2T606A, KT606A	10 нс	
KT606B	12 нс	
Емкость коллекторного перехода при $U_{K\bar{B}} = 28$ В, $f = 5$ МГц не более	10 пФ	
Емкость эмиттерного перехода при $U_{\bar{E}B} = 0$, $f = 5$ МГц не более	27 пФ	
Обратный ток коллектор-эмиттер при $U_{K\bar{E}} = 65$ В, $R_{\bar{E}B} = 100$ Ом не более: при $T = 298$ К		
2T606A	1 мА	
KT606A, KT606B	1,5 мА	
при $T = 358$ К		
KT606A, KT606B	3 мА	
при $T = 398$ К	2 мА	
Обратный ток эмиттера при $U_{\bar{E}B} = 4$ В при $T = 298$ К не более:		
2T606A	0,1 мА	
KT606A, KT606B	0,3 мА	

Пределевые эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{BE} \leq 10$ Ом:	
2T606A	65 В
KT606A, KT606B	60 В
Пиковое напряжение коллектор-эмиттер при $f \geq 100$ МГц:	
2T606A	5 В
KT606A, KT606B	70 В
Постоянное напряжение эмиттер-база	4 В
Постоянный ток коллектора	400 мА
Пиковый ток коллектора	800 мА
Постоянный ток базы	100 мА
Средняя рассеиваемая мощность в динамическом режиме:	
при $T_x = 313$ К	2.5 Вт
при $T_x = 398$ К 2T606A	0.57 Вт
Тепловое сопротивление переход-корпус	44 К.Вт
Temperatura перехода:	
2T606A	423 К
KT606A, KT606B	393 К
Temperatura окружающей среды:	
2T606A	От 213 до $T_x = 398$ К
KT606A, KT606B	От 233 до $T_x = 358$ К

Примечание. При монтаже транзисторов допускается усилие, перпендикулярное оси вывода, не более 50 г, категорически запрещается изгиб выводов, а также их кручение вокруг оси.

Пайка выводов допускается на расстоянии не менее 1 мм от корпуса транзистора.

Использование транзистора без теплоотвода не рекомендуется.

Чистота контактной поверхности теплоотводов должна быть менее 2.5. Неплоскость контактной поверхности теплоотвода должна быть не более 0.03 мм.